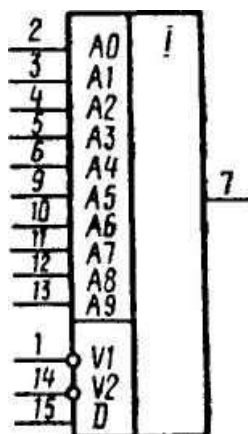


К155РУ7

Микросхема представляет собой оперативное запоминающее устройство на 1024 бит (1024 слов x 1 разряд) со схемами управления. ИС выполняет следующие алгоритмы функционирования: запись, хранение, считывание информации при произвольной последовательности адресов. Содержит 7500 интегральных элементов. Корпус типа 238.16-2, масса не более 2 г.



Условное графическое обозначение К155РУ7

Назначение выводов: 1 - вход разрешения выборки кристалла V1; 2 - вход адреса A0; 3 - вход адреса A1; 4 - вход адреса A2; 5 - вход адреса A3; 6 - вход адреса A4; 7 - выход информации; 8 - общий; 9 - вход адреса A5; 10 - вход адреса A6; 11 - вход адреса A7; 12 - вход адреса A8; 13 - вход адреса A9; 14 - вход разрешения записи V2; 15 - вход информации D; 16 - напряжение питания.

Электрические параметры

| | |
|--|---------------|
| Номинальное напряжение питания | 5 В ± 5% |
| Выходное напряжение низкого уровня | ≤ 0,45 В |
| Выходное напряжение высокого уровня | ≥ 2,4 В |
| Напряжение на антизвонном диоде | ≥ -1,5 В |
| Входной ток низкого уровня | ≤ -0,4 мА |
| Входной ток высокого уровня..... | ≤ 0,04 мА |
| Входной ток в состоянии «выключено» | ± 50 мкА |
| Ток короткого замыкания | ≤ 100 мА |
| Ток потребления | ≤ 140 мА |
| Удельная потребляемая мощность | ≤ 0,7 мВт/бит |
| Время выборки адреса для перехода из состояния низкого уровня в состояние высокого уровня | ≤ 45 нс |
| Время выборки адреса для перехода из состояния высокого уровня в состояние низкого уровня | ≤ 45 нс |

| | |
|--|---------|
| Время выборки разрешения для перехода из третьего состояния в состояние низкого уровня | ≤ 35 нс |
| Время выборки разрешения для перехода из третьего состояния в состояние высокого уровня..... | ≤ 35 нс |
| Время выборки хранения для перехода из состояния низкого уровня в третье состояние | ≤ 35 нс |
| Время выборки хранения для перехода из состояния высокого уровня в третье состояние | ≤ 35 нс |
| Время выборки записи для перехода из состояния низкого уровня в третье состояние | ≤ 35 нс |
| Время выборки записи для перехода из состояния высокого уровня в третье состояние | ≤ 35 нс |
| Время выборки считывания для перехода из третьего состояния в состояние низкого уровня | ≤ 40 нс |
| Время выборки считывания для перехода из третьего состояния в состояние высокого уровня..... | ≤ 40 нс |
| Входная емкость..... | ≤ 5 пФ |
| Выходная емкость | ≤ 8 пФ |